

ロシア・ベラルーシ禁輸リストの日米対照表

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 1 条</b></p> <p>一 マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ及びマイクロコントローラであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が 32 以上のものであって、浮動小数点演算処理を一秒間に 50 億以上実現できるもの</p> <p>ロ クロック周波数が 25 MHz を超えるもの</p> <p>ハ 並列プロセッサ用に設計したものであって、転送速度が 2.5MB 毎秒を超える外部との相互接続のためのデータバス、命令バス又は直列通信ポートのいずれかを二以上有するもの</p>	<p>3A991 Electronic devices, and “components” not controlled by 3A001.</p> <p>※ EU リストの X.A.I.001 項も同内容</p> <p>a. “Microprocessor microcircuits”, “microcomputer microcircuits”, and microcontroller microcircuits having any of the following:</p> <p>a.1. A performance speed of 5 GFLOPS or more and an arithmetic logic unit with an access width of 32 bit or more;</p> <p>a.2. A clock frequency rate exceeding 25 MHz; or</p> <p>a.3. More than one data or instruction bus or serial communication port that provides a direct external interconnection between parallel “microprocessor microcircuits” with a transfer rate of 2.5 Mbyte/s;</p>
<p>二 集積回路に用いられる記憶素子であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ プログラムを電氣的に消去することができるプログラマブルロムであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) フラッシュメモリーであって、パッケージ当たりの記憶容量が 16 メガビットを超えるもの</p> <p>(二) (一) 以外のプログラマブルロムであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>1 パッケージ当たりの記憶容量が 1 メガビットを超えるもの</p> <p>2 パッケージ当たりの記憶容量が 256 キロビットを超えるものであって、最大アクセス時間が 80 n 秒未満のもの</p> <p>ロ スタティック式のラムであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) パッケージ当たりの記憶容量が 1 メガビットを超えるもの</p> <p>(二) パッケージ当たりの記憶容量が 256K ビットを超えるものであって、最大アクセス時間が 25n 秒未満のもの</p>	<p>b. Storage integrated circuits, as follows:</p> <p>b.1. Electrical erasable programmable read only memories (EEPROMs) with a storage capacity;</p> <p>b.1.a. Exceeding 16 Mbits per package for flash memory types; or</p> <p>b.1.b. Exceeding either of the following limits for all other EEPROM types:</p> <p>b.1.b.1. Exceeding 1 Mbit per package; or</p> <p>b.1.b.2. Exceeding 256 kbit per package and a maximum access time of less than 80 ns;</p> <p>b.2. Static random access memories (SRAMs) with a storage capacity:</p> <p>b.2.a. Exceeding 1 Mbit per package; or</p> <p>b.2.b. Exceeding 256 kbit per package and a maximum access time of less than 25 ns;</p>

ロシア・ベラルーシ禁輸リストの日米対照表

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第一条</b></p> <p>三 アナログデジタル変換器及びアナログデジタル変換用の集積回路であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 分解能が 8 ビット以上 12 ビット未満のものであって、出力ワードレートが 200 メガワード毎秒を超えるもの</p> <p>ロ 分解能が 12 ビットのものであって、出力ワードレートが 105 メガワード毎秒を超えるもの</p> <p>ハ 分解能が 12 ビット超 14 ビット以下のものであって、出力ワードレートが 10M ワード毎秒を超えるもの</p> <p>ニ 分解能が 14 ビットを超えるものであって、出力ワードレートが 2.5 メガワード毎秒を超えるもの</p>	<p><b>3A991</b></p> <p><b>c. Analog-to-digital converters having any of the following:</b></p> <p>c.1. A resolution of 8 bit or more, but less than 12 bit, with an output rate greater than 200 million words per second;</p> <p>c.2. A resolution of 12 bit with an output rate greater than 105 million words per second;</p> <p>c.3. A resolution of more than 12 bit but equal to or less than 14 bit with an output rate greater than 10 million words per second; or</p> <p>c.4. A resolution of more than 14 bit with an output rate greater than 2.5 million words per second;</p>
<p>四 フィールドプログラマブルロジックデバイス（コンプレックスプログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ、フィールドプログラマブルロジックアレイ及びフィールドプログラマブル相互接続用集積回路を含む。）であって、シングルエンド方式の最大デジタル入出力数が 200 以上 700 以下のもの</p>	<p><b>d. Field programmable logic devices</b> having a maximum number of single-ended digital input/outputs between 200 and 700;</p>
<p>五 FFT プロセッサであって、複素点の数が 1,024 のとき、高速フーリエ変換の定格実行時間が 1m 秒未満のもの</p>	<p><b>e. Fast Fourier Transform (FFT) processors</b> having a rated execution time for a 1,024 point complex FFT of less than 1 ms;</p>
<p>六 カスタム集積回路であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 端子数が 144 を超えるもの</p> <p>ロ 基本伝搬遅延時間が 0.4 ナノ秒未満のもの</p>	<p><b>f. Custom integrated circuits</b> for which either the function is unknown, or the control status of the equipment in which the integrated circuits will be used is unknown to the manufacturer, having any of the following:</p> <p>f.1. More than 144 terminals; or</p> <p>f.2. A typical “basic propagation delay time” of less than 0.4 ns;</p>

ロシア・ベラルーシ禁輸リストの日米対照表

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 1 条</b></p> <p>七 進行波真空電子デバイス（クライストロン及び進行波管並びにこれらから派生したものを含む。）であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 空洞結合形のもの</p> <p>ロ ヘリックス形のもの、折返し導波形のもの及び蛇行導波管回路形のものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 半オクターブ以上の瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力電力の数値にギガヘルツで表した場合の最大動作周波数を乗じて得た数値が 0.2 を超えるもの</p> <p>(二) 半オクターブ未満の瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力電力の数値にギガヘルツで表した場合の最大動作周波数を乗じて得た数値が 0.4 を超えるもの</p>	<p><b>3A991</b></p> <p><b>g. Traveling-wave “vacuum electronic devices,”</b> pulsed or continuous wave, as follows:</p> <p>g.1. Coupled cavity devices, or derivatives thereof;</p> <p>g.2. Helix devices based on helix, folded waveguide, or serpentine waveguide circuits, or derivatives thereof, with any of the following:</p> <p>g.2.a. An “instantaneous bandwidth” of half an octave or more; and</p> <p>g.2.b. The product of the rated average output power (expressed in kW) and the maximum operating frequency (expressed in GHz) of more than 0.2;</p> <p>g.2.c. An “instantaneous bandwidth” of less than half an octave; and</p> <p>g.2.d. The product of the rated average output power (expressed in kW) and the maximum operating frequency (expressed in GHz) of more than 0.4</p>
<p>八 40GHz を超える周波数で使用するために設計した弾力性のある導波管</p>	<p><b>h. Flexible waveguides</b> designed for use at frequencies exceeding 40 GHz;</p>
<p>九 表面弾性波及び疑似表面弾性波を利用するものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 搬送周波数が一ギガヘルツを超えるもの</p> <p>ロ 搬送周波数が一ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) サイドローブに対するメインローブの電力の比が 55 dB を超えるもの</p> <p>(二) マイクロ秒で表した場合の最大遅延時間の数値にメガヘルツで表した場合の帯域幅の数値を乗じて得た数値が 100 を超えるもの</p> <p>(三) 分散型遅延時間が 10 マイクロ秒を超えるもの</p>	<p><b>i. Surface acoustic wave and surface skimming (shallow bulk) acoustic wave devices</b> (i.e., “signal processing” devices employing elastic waves in materials), having either of the following:</p> <p>i.1. A carrier frequency exceeding 1 GHz; or</p> <p>i.2. A carrier frequency of 1 GHz or less; and</p> <p>i.2.a. A frequency side-lobe rejection exceeding 55 Db;</p> <p>i.2.b. A product of the maximum delay time and bandwidth (time in microseconds and bandwidth in MHz) of more than 100; or</p> <p>i.2.c. A dispersive delay of more than 10 microseconds;</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 1 条</b></p> <p>十 セル（バッテリー（シングルセルバッテリーを含む。）に組み込まれているものを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 一次セルであって、二〇度におけるエネルギー密度が 550W 時毎kg 以下のもの</p> <p>ロ 二次セルであって、二〇度におけるエネルギー密度が 350W 時毎kg 以下のもの</p>	<p><b>3A991</b></p> <p><b>j. Cells as follows:</b></p> <p>j.1. Primary cells having an energy density of 550 Wh/kg or less at 293 K (20°C)</p> <p>j.2. Secondary cells having an energy density of 350 Wh/kg or less at 293 K (20°C);</p> <p>Note: 3A991.j does not control batteries, including single cell batteries</p>
<p>十一 一分を要しないで磁界を完全に形成させ又は消失させるように特に設計した<b>超電導電磁石</b>（ソレノイドコイル形のものを含む。）であって、次のイからハまでの全てに該当するもの</p> <p>イ 減磁の際に放出する最大エネルギーを減磁の持続時間で除して得た値が 500kJ／分を超えるもの</p> <p>ロ コイルの内径が 250mmを超えるもの</p> <p>ハ コイルの定格最大電流密度が 300A／mm<sup>2</sup>を超えるもの又は定格磁束密度が 8T を超えるもの</p>	<p><b>k. “Superconductive” electromagnets or solenoids</b> “specially designed” to be fully charged or discharged in less than one minute, having all of the following:</p> <p>Note: 3A991.k does not control “superconductive” electromagnets or solenoids designed for Magnetic Resonance Imaging (MRI) medical equipment.</p> <p>k.1. Maximum energy delivered during the discharge divided by the duration of the discharge of more than 500 kJ per minute;</p> <p>k.2. Inner diameter of the current carrying windings of more than 250 mm; and</p> <p>k.3. Rated for a magnetic induction of more than 8T or “overall current density” in the winding of more than 300 A/mm<sup>2</sup></p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 1 条</b></p> <p>十二 電磁エネルギーを貯蔵するための装置のうち、超電導材料を用いたものであって、次のイからニまでの全てに該当するもの</p> <p>イ 使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用できるように特に設計したもの</p> <p>ロ 共振周波数が 1MHz を超えるもの</p> <p>ハ 貯蔵されるエネルギー密度が 1MJ 毎立方メートル以上のもの</p> <p>ニ エネルギー放出時間が 1m 秒未満のもの</p>	<p><b>3A991</b></p> <p><b>ℓ. Circuits or systems for electromagnetic energy storage</b>, containing “components” manufactured from “superconductive” materials “specially designed” for operation at temperatures below the “critical temperature” of at least one of their “superconductive” constituents, having all of the following:</p> <p>ℓ.1. Resonant operating frequencies exceeding 1 MHz;</p> <p>ℓ.2. A stored energy density of 1 MJ/m<sup>3</sup> or more; and</p> <p>ℓ.3. A discharge time of less than 1 ms;</p>
<p>十三 セラミック及び金属構造の水素又は水素同位体サイラトロンであって、ピーク電流が 500A 以上のもの</p>	<p><b>m. Hydrogen/hydrogen-isotope thyratrons</b> of ceramic-metal construction and rate for a peak current of 500 A or more;</p>
<p>十四 化合物半導体を用いたデジタル方式の集積回路であって、等価ゲート数が二入力ゲート換算で 300 を超えるもの</p>	<p><b>n. Digital integrated circuits based on any compound semiconductor</b> having an equivalent gate count of more than 300 (2 input gates)</p>
<p>十五 太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル及び太陽光アレーであって、宇宙用に設計したもの</p>	<p><b>o. Solar cells, cell-interconnect-coverglass (CIC) assemblies, solar panels, and solar arrays</b>, which are “space qualified” and not controlled by 3A001.e.4.</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 2 条</b> 一 電子式の試験装置</p>	<p><b>3A992 General purpose electronic equipment not controlled by 3A002</b> ※ EU リストの X. A. I. 002 項も同内容 <b>a. Electronic test equipment, n.e.s</b></p>
<p>二 計測用のデジタル磁気テープ記録装置であって、次のいずれかに該当するもの イ 装置間の最大転送速度が、60 メガビット毎秒を超えるものであって、ヘリカル走査技術を用いたもの ロ 装置間の最大転送速度が、120 メガビット毎秒を超えるものであって、固定ヘッド技術を用いたもの ハ 宇宙用に設計したもの</p>	<p><b>b. Digital instrumentation magnetic tape data recorders</b> having any of the following characteristics: b.1. A maximum digital interface transfer rate exceeding 60 Mbit/s and employing helical scan techniques; b.2. A maximum digital interface transfer rate exceeding 120 Mbit/s and employing fixed head techniques; or b.3. “Space qualified”</p>
<p>三 デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を変換して計測用のデジタル磁気テープ記録装置として使用できるように設計した装置であって、装置間の最大転送速度が 60 メガビット毎秒を超えるもの</p>	<p><b>c. Equipment, with a maximum digital interface transfer rate exceeding 60 Mbit/s, designed to convert digital video magnetic tape recorders for use as digital instrumentation data recorders;</b></p>
<p>四 アナログ方式のオシロスコープ及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの イ アナログ方式のオシロスコープであって、帯域幅が 1 GHz 以上のもの ロ 差し込みモジュールであって、個々の帯域幅が 4 GHz 以上のもの</p>	<p><b>d. Non-modular analog oscilloscopes</b> having a bandwidth of 1 GHz or greater; <b>e. Modular analog oscilloscope systems</b> having either of the following characteristics: e.1. A mainframe with a bandwidth of 1 GHz or greater; or e.2. Plug-in modules with an individual bandwidth of 4 GHz or greater;</p>
<p>五 繰り返し現象を分析するためのアナログ方式のサンプリングオシロスコープであって、実効帯域幅が 4 GHz を超えるもの</p>	<p><b>f. Analog sampling oscilloscopes</b> for the analysis of recurring phenomena with an effective bandwidth greater than 4 GHz;</p>
<p>六 アナログデジタル変換技術を有するデジタル方式のオシロスコープ及び波形記憶装置であって、次のイからハまでの全てに該当するもの イ 単発の入力信号を 1 ナノ秒未満の間隔で連続してサンプリングできるように設計したもの ロ 分解能が 8 ビット以上のもの ハ 256 以上のサンプルを記録することができるもの</p>	<p><b>g. Digital oscilloscopes and transient recorders, using analog-to-digital conversion techniques, capable of storing transients by sequentially sampling single-shot inputs at successive intervals of less than 1 ns (greater than 1 gigasample per second), digitizing to 8 bits or greater resolution and storing 256 or more samples.</b></p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 3 条</b></p> <p>一 周波数変換器であって、300 Hzから 600 Hzの周波数範囲で動作するもの</p>	<p><b>3A999 Specific processing equipment, n.e.s.,</b> as follows (see List of Items Controlled).</p> <p>※ EU リストの X. A. I. 003 項も同内容</p> <p><b>a. Frequency changers</b> capable of operating in the frequency range from 300 up to 600 Hz, n.e.s;</p>
<p>二 質量分析計</p>	<p><b>b. Mass spectrometers n.e.s;</b></p>
<p>三 フラッシュ放電型のエックス線装置及びそのために設計したパルス電源装置の部分品</p>	<p>c. All flash x-ray machines, and “parts” or “components” of pulsed power systems designed thereof, including Marx generators, high power pulse shaping networks, high voltage capacitors, and triggers</p>
<p>四 パルス増幅器</p>	<p><b>d. Pulse amplifiers, n.e.s.;</b></p>
<p>五 遅延時間の発生又は時間間隔の測定のための装置であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ デジタル方式の遅延時間の発生のための装置であって、時間間隔が一マイクロ秒以上で、五〇ナノ秒以下の分解能を有するもの</p> <p>ロ 三以上のマルチチャンネル又はモジュール式の時間間隔の測定のための装置及びクロノメータであって、時間間隔が一マイクロ秒以上で、50ナノ秒以下の分解能を有するもの</p>	<p><b>e. Electronic equipment for time delay generation or time interval measurement,</b> as follows:</p> <p>e.1. Digital time delay generators with a resolution of 50 nanoseconds or less over time intervals of 1 microsecond or greater; or</p> <p>e.2. Multi-channel (three or more) or modular time interval meter and chronometry equipment with resolution of 50 nanoseconds or less over time intervals of 1 microsecond or greater;</p>
<p>六 クロマトグラフ及び分光計</p>	<p><b>f. Chromatography and spectrometry</b> analytical instruments.</p>



別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 4 条</b></p> <p>一 第一条又は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（以下「貨物等省令」という。）第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する電子管、光学素子及びこれらの部分品の製造のために特に設計した装置</p>	<p><b>3B991 Equipment not controlled by 3B001 for the manufacture of electronic “parts,” “components” and materials, and “specially designed” “parts,” “components” and “accessories” therefor</b></p> <p>※ EU リストの X.B.I.001 項も同内容</p> <p>a. Equipment “specially designed” for the manufacture of electron tubes, optical elements and “specially designed” “parts” and “components” therefor controlled by 3A001 or 3A991</p>
<p>二 半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用に特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置</p> <p>イ 半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用の材料の加工装置であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 多結晶シリコン及び貨物等省令第六条第十八号に該当する貨物の製造用の装置</p> <p>(二) III—V 族及び II—VI 族の半導体物質（貨物等省令第六条第十八号から第二十三号までのいずれかに該当するものに限る。）の製造のために特に設計した装置（(三) に該当するものを除く。）</p>	<p>b. Equipment “specially designed” for the manufacture of semiconductor devices, integrated circuits and “electronic assemblies”, as follows, and systems incorporating or having the characteristics of such equipment:</p> <p><b>b.1. Equipment for the processing of materials for the manufacture of devices, “parts” and “components” as specified in the heading of 3B991.b, as follows:</b></p> <p>b.1.a. Equipment for producing polycrystalline silicon and materials controlled by 3C001</p> <p>b.1.b. Equipment “specially designed” for purifying or processing III/V and II/VI semiconductor materials controlled by 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, or 3C005 except crystal pullers, for which see 3B991.b.1.c below;</p>



別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 4 条 二号イ のつづき</b></p> <p>(三) 結晶の引上げ装置及び炉であって、次のいずれかに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 アニール装置及び再結晶のための装置（定温炉を除く。）であって、0.005 m<sup>2</sup>毎分を超える速度でウエハーを処理できるエネルギー移動率を有するもの</li> <li>2 プログラム内蔵方式の結晶の引上げ装置であって、次のいずれかに該当するもの                     <ol style="list-style-type: none"> <li>一 るつぽを取り替えることなく再充填できるもの</li> <li>二 0.25 MPaを超える圧力で動作するもの</li> <li>三 引き上げることができる結晶の直径が 100 mmを超えるもの</li> </ol> </li> </ol> <p>(四) プログラム内蔵方式のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 200 mm以上にわたり厚さの許容差の絶対値が 2.5%未満となるシリコン膜を形成できるもの</li> <li>2 ウエハー全体にわたり厚さの許容差の絶対値が 3.5%以下となるシリコン膜以外の膜を形成できるもの</li> <li>3 処理中にウエハーを回転できるもの</li> </ol> <p>(五) 分子線エピタキシャル成長装置</p>	<p><b>3B991b1 のつづき</b></p> <p>b.1.c. Crystal pullers and furnaces, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1.c.1. Annealing or recrystallizing equipment other than constant temperature furnaces employing high rates of energy transfer capable of processing wafers at a rate exceeding 0.005 m<sup>2</sup> per minute;</li> <li>b.1.c.2. “Stored program controlled” crystal pullers having any of the following characteristics:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1.c.2.a. Rechargeable without replacing the crucible container;</li> <li>b.1.c.2.b. Capable of operation at pressures above 2.5 x 10<sup>5</sup> Pa; or</li> <li>b.1.c.2.c. Capable of pulling crystals of a diameter exceeding 100 mm</li> </ol> </li> <li>b.1.d. “Stored program controlled” equipment for epitaxial growth having any of the following characteristics:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1.d.1. Capable of producing silicon layer with a thickness uniform to less than □ 2.5% across a distance of 200 mm or more;</li> <li>b.1.d.2. Capable of producing a layer of any material other than silicon with a thickness uniformity across the wafer of equal to or better than □ 3.5%; or</li> <li>b.1.d.3. Rotation of individual wafers during processing</li> </ol> </li> <li>b.1.e. Molecular beam epitaxial growth equipment</li> </ol>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 4 条 二号イ のつづき</b></p> <p>(六) 真空環境でウエハーを搬送するために特に設計したロードロック機能を備え、かつ、磁氣的に強化されたスパッタリング装置</p> <p>(七) イオン注入、イオン増速拡散又は光増速拡散のために特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 パターン形成を行うことができるもの</li> <li>2 ビームエネルギーが 200keV を超えるもの</li> <li>3 ビームエネルギーが 10keV 未満で使用できるように設計したもの</li> <li>4 加熱した基板に酸素を注入できるもの</li> </ol> <p>(八) プログラム内蔵方式の異方性ドライエッチング用の装置であって、次のいずれかに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 バッチ方式のものであって、次のいずれかに該当するもの             <ol style="list-style-type: none"> <li>一 終点検知機能を有するもの（発光分光式のものを除く。）</li> <li>二 反応炉のエッチング圧力が 26.66 Pa 以下のもの</li> </ol> </li> <li>2 単一ウエハー方式のものであって、次のいずれかに該当するもの             <ol style="list-style-type: none"> <li>一 終点検知機能を有するもの（発光分光式のものを除く。）</li> <li>二 反応炉のエッチング圧力が 26.66 Pa 以下のもの</li> <li>三 カセットツウカセット機能及びロードロック式のウエハー搬送機能を有するもの</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>3B991b1 つづき</b></p> <p>b.1.f. Magnetically enhanced ‘sputtering’ equipment with “specially designed” integral load locks capable of transferring wafers in an isolated vacuum environment;</p> <p>b.1.g. Equipment “specially designed” for ion implantation, ion-enhanced or photo-enhanced diffusion, having any of the following characteristics:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1.g.1. Patterning capability;</li> <li>b.1.g.2. Beam energy (accelerating voltage) exceeding 200 keV;</li> <li>b.1.g.3 Optimized to operate at a beam energy (accelerating voltage) of less than 10 keV; or</li> <li>b.1.g.4. Capable of high energy oxygen implant into a heated “substrate”;</li> </ol> <p>b.1.h. “Stored program controlled” equipment for the selective removal (etching) by means of anisotropic dry methods (e.g., plasma), as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1.h.1. Batch types having either of the following:             <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1.h.1.a. End-point detection, other than optical emission spectroscopy types; or</li> <li>b.1.h.1.b. Reactor operational (etching) pressure of 26.66 Pa or less</li> </ol> </li> <li>b.1.h.2. Single wafer types having any of the following:             <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1.h.2.a. End-point detection, other than optical emission spectroscopy types;</li> <li>b.1.h.2.b. Reactor operational (etching) pressure of 26.66 Pa or less; or</li> <li>b.1.h.2.c. Cassette-to-cassette and load locks wafer handling</li> </ol> </li> </ol>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 4 条 二号イ の つづき</b></p> <p>(九) 半導体素子製造用の化学的気相成長装置のうち、酸化物、窒化物、金属又は多結晶シリコンを堆積させることができるものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 0.1 MPa未満の圧力で動作するもの</li> <li>2 プラズマ増殖型のものであって、60 Pa未満の圧力で動作するもの並びに自動カセットツウカセット機能及びロードロック式のウエハー搬送機能を有するもの</li> </ol> <p>(十) マスク、レチクル又は半導体素子の製造用に特に設計又は改造した電子ビーム装置であって、次のいずれかに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 電子ビームを静電偏向させることができるもの</li> <li>2 非ガウス形の電子ビーム形状を形成することができるもの</li> <li>3 デジタルからアナログへの変換速度が 3MHz を超えるもの</li> <li>4 デジタルからアナログへの変換精度が 12 ビットを超えるもの</li> <li>5 目標に対するビームの位置決めをフィードバック方式により行うものであって、位置決め精度の絶対値が 1 μm以下のもの</li> </ol> <p>(十一) ウエハーの表面仕上げ装置であって、次のいずれかに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 100 μmより薄いウエハーの裏面を加工し、かつ、加工後のウエハーを剥離することができるように特に設計したもの</li> <li>2 加工されたウエハーの表面粗さを、二シグマ値で 2 μm以下に仕上げるために特に設計した装置</li> </ol>	<p><b>3B991b1 つづき</b></p> <p>b.1.i. “Chemical vapor deposition” (CVD) equipment, e.g., plasma-enhanced CVD (PECVD) or photo-enhanced CVD, for semiconductor device manufacturing, having either of the following capabilities, for deposition of oxides, nitrides, metals or polysilicon:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1.i.1. “Chemical vapor deposition” equipment operating below 10<sup>5</sup> Pa; or</li> <li>b.1.i.2. PECVD equipment operating either below 60 Pa (450 millitorr) or having automatic cassette-to-cassette and load lock wafer handling;</li> </ol> <p>b.1.j. Electron beam systems “specially designed” or modified for mask making or semiconductor device processing having any of the following characteristics:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1.j.1. Electrostatic beam deflection;</li> <li>b.1.j.2. Shaped, non-Gaussian beam profile;</li> <li>b.1.j.3. Digital-to-analog conversion rate exceeding 3 MHz;</li> <li>b.1.j.4. Digital-to-analog conversion accuracy exceeding 12 bit; or</li> <li>b.1.j.5. Target-to-beam position feedback control precision of 1 micrometer or finer;</li> </ol> <p>b.1.k. Surface finishing equipment for the processing of semiconductor wafers as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1.k.1. “Specially designed” equipment for backside processing of wafers thinner than 100 micrometer and the subsequent separation thereof; or</li> <li>b.1.k.2. “Specially designed” equipment for achieving a surface roughness of the active surface of a processed wafer with a two-sigma value of 2 micrometer or less, total indicator reading (TIR);</li> </ol>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 4 条二号イ のつづき</b></p> <p>(十二) 単一又は複数の真空チャンバーを搭載した相互接続用の装置であつて、本条に該当する装置を統合するように特に設計したもの</p> <p>(十三) レーザー光を使用したモノリシック集積回路の修理又はトリミング用のプログラム内蔵方式の装置であつて、次のいずれかに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 位置決め精度の絶対値が 1 μm未満のもの</li> <li>2 照射面の直径（切り溝幅）が 3 μm未満のもの</li> </ol> <p><b>ロ マスク、マスク基板、マスク製造装置及び画像転写装置</b>であつて、半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用のもののうち、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 完成したマスク及びレチクル（次のいずれかに該当するものを除く。）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 第一条又は貨物等省令第六条第一号に該当しない集積回路を製造するためのもの</li> <li>2 次の一及び二に該当するもの             <ol style="list-style-type: none"> <li>一 設計寸法が 2.5 μm以上のもの</li> <li>二 製造用の装置又はソフトウェアによって使用目的を変更することができる特別な性質を有さないものとして設計したもの</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>3B991b1 のつづき</b></p> <p>b.1.1. Interconnection equipment which includes common single or multiple vacuum chambers “specially designed” to permit the integration of any equipment controlled by 3B991 into a complete system;</p> <p>b.1.m. “Stored program controlled”equipment using “lasers” for the repair or trimming of “monolithic integrated circuits” with either of the following characteristics:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1.m.1. Positioning accuracy less than □ 1 micrometer; or</li> <li>b.1.m.2. Spot size (kerf width) less than 3 micrometer</li> </ol> <p><b>b.2. Masks, mask “substrates,” mask-making equipment and image transfer equipment</b> for the manufacture of devices, “parts” and “components” as specified in the heading of 3B991, as follows:</p> <p>b.2.a. Finished masks, reticles and designs therefor, except:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b.2.a.1. Finished masks or reticles for the production of unembargoed integrated circuits; or</li> <li>b.2.a.2. Masks or reticles, having both of the following characteristics:             <ol style="list-style-type: none"> <li>b.2.a.2.a. Their design is based on geometries of 2.5 micrometer or more; and</li> <li>b.2.a.2.b. The design does not include special features to alter the intended use by means of production equipment or “software”;</li> </ol> </li> </ol>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 4 条 二号ロ のつづき</b></p> <p>(二) マスク基板であって、次のいずれかに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 硬質表面で被覆したものであって、寸法が 125 mm 四方を超えるもの</li> <li>2 エックス線マスク用に特に設計したもの</li> </ol> <p>(三) 半導体素子又は集積回路の CAD プログラムを動作させるために特に設計した装置（汎用の電子計算機を除く。）</p> <p>(四) マスク又はレチクル製造用の装置及びその附属品であって、次のいずれかに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 光学方式によるステップアンドリピート方式の露光装置であって、次のいずれかに該当するもの                     <ol style="list-style-type: none"> <li>一 100 mm 四方を超える範囲に連続してパターンを焼き付けることができるもの</li> <li>二 一回で 6 mm 四方を超える範囲にパターンを焼き付けることができるもの</li> <li>三 2.5 μm 未満の線幅を基板上のフォトレジストに焼き付けることができるもの</li> </ol> </li> <li>2 イオンビーム又はレーザービームリソグラフィを用いたマスク又はレチクル製造用の装置であって、2.5 μm 未満の線幅を焼き付けることができるもの</li> <li>3 マスク若しくはレチクルの改造又は欠陥除去用のペリクルの追加のための装置及びホルダー</li> </ol>	<p><b>3B991b2 のつづき</b></p> <p>b.2.b. Mask “substrates” as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b.2.b.1. Hard surface (e.g., chromium, silicon, molybdenum) coated “substrates” (e.g., glass, quartz, sapphire) for the preparation of masks having dimensions exceeding 125 mm x 125 mm; or</li> <li>b.2.b.2. “Substrates” “specially designed” for X-ray masks;</li> </ol> <p>b.2.c. Equipment, other than general purpose computers, “specially designed” for computer aided design (CAD) of semiconductor devices or integrated circuits;</p> <p>b.2.d. Equipment or machines, as follows, for mask or reticle fabrication:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b.2.d.1. Photo-optical step and repeat cameras capable of producing arrays larger than 100 mm x 100 mm, or capable of producing a single exposure larger than 6 mm x 6 mm in the image (i.e., focal) plane, or capable of producing line widths of less than 2.5 micrometer in the photoresist on the “substrate”;</li> <li>b.2.d.2. Mask or reticle fabrication equipment using ion or “laser” beam lithography capable of producing line widths of less than 2.5 micrometer; or</li> <li>b.2.d.3. Equipment or holders for altering masks or reticles or adding pellicles to remove defects;</li> </ol>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 4 条 二号ロ のつづき</b></p> <p>(五) マスク、レチクル又はペリクルの検査装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次の 1 及び 2 に該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 分解能が 0.25 <math>\mu\text{m}</math> 以下のもの</li> <li>2 一軸又は二軸の座標上における 63.5 mm 以上の距離において、位置決め精度の絶対値が 0.75 <math>\mu\text{m}</math> 以下のもの</li> </ol> <p>(六) ウエハー製造用の露光装置であって、光学方式のもの又はエックス線を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 2.5 <math>\mu\text{m}</math> 未満の線幅を焼き付けることができるもの</li> <li>2 位置決め精度の絶対値が 0.25 <math>\mu\text{m}</math> (平均値に三シグマを加えたもの) 未満のもの</li> <li>3 機械間の重ね合わせ精度の絶対値が 0.3 <math>\mu\text{m}</math> 以上のもの</li> <li>4 光源の波長が 400 nm 未満のもの</li> </ol> <p>(七) 電子ビーム装置、イオンビーム装置及びエックス線装置であって、2.5 <math>\mu\text{m}</math> 未満の線幅を焼き付けることができるもの</p> <p>(八) レーザー発振器を用いた装置のうち、ウエハーに直接描画方式で 2.5 <math>\mu\text{m}</math> 未満の線幅を焼き付けることができるもの</p>	<p><b>3B991b2 のつづき</b></p> <p>b.2.e. “Stored program controlled” equipment for the inspection of masks, reticles or pellicles with:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b.2.e.1. A resolution of 0.25 micrometer or finer; and</li> <li>b.2.e.2. A precision of 0.75 micrometer or finer over a distance in one or two coordinates of 63.5 mm or more;</li> </ol> <p>b.2.f. Align and expose equipment for wafer production using photo-optical or X-ray methods, e.g., lithography equipment, including both projection image transfer equipment and step and repeat (direct step on wafer) or step and scan (scanner) equipment, capable of performing any of the following functions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b.2.f.1. Production of a pattern size of less than 2.5 micrometer;</li> <li>b.2.f.2. Alignment with a precision finer than <math>\square</math> 0.25 micrometer (3 sigma);</li> <li>b.2.f.3. Machine-to-machine overlay no better than <math>\square</math> 0.3 micrometer; or</li> <li>b.2.f.4. A light source wavelength shorter than 400 nm;</li> </ol> <p>b.2.g. Electron beam, ion beam or X-ray equipment for projection image transfer capable of producing patterns less than 2.5 micrometer;</p> <p>b.2.h. Equipment using “lasers” for direct write on wafers capable of producing patterns less than 2.5 micrometer.</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 4 条</b>のつづき</p> <p>ハ 集積回路の組立用の装置であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) プログラム内蔵方式のダイボンダーであって、次の 1 から 3 までの全てに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ハイブリッド集積回路のために特に設計したもの</li> <li>2 縦軸及び横軸に沿って 37.5 mm を超えた移動ができるステージを有するもの</li> <li>3 縦軸及び横軸に沿った面における配置の精度の絶対値が 10 μm 未満のもの</li> </ol> <p>(二) プログラム内蔵方式のダイボンダーであって、一回の動作で二以上の結線を行うことができるもの</p> <p>(三) パッケージのキャップを当該パッケージのキャップ以外の部分より高い温度に加熱できる装置のうち、次の 1 から 3 までの全てに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 半自動又は全自動のもの</li> <li>2 毎分一パッケージ以上処理できるもの</li> <li>3 貨物等省令第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当するセラミック集積回路のパッケージ用に特に設計したもの</li> </ol> <p>ニ 空気中における径が 0.3 μm 以下の粒子の数を 0.02832 m<sup>3</sup> 当たり 10 個以下とすることができるクリーンルーム用のフィルター及びその材料</p>	<p><b>3 B991b</b> つづき</p> <p><b>b.3. Equipment for the assembly of integrated circuits</b>, as follows:</p> <p>b.3.a. “Stored program controlled” die bonders having all of the following characteristics:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b.3.a.1. “Specially designed” for “hybrid integrated circuits”;</li> <li>b.3.a.2. X-Y stage positioning travel exceeding 37.5 x 37.5 mm; and</li> <li>b.3.a.3. Placement accuracy in the X-Y plane of finer than □ 10 micrometer;</li> </ol> <p>b.3.b. “Stored program controlled” equipment for producing multiple bonds in a single operation (e.g., beam lead bonders, chip carrier bonders, tape bonders);</p> <p>b.3.c. Semi-automatic or automatic hot cap sealers, in which the cap is heated locally to a higher temperature than the body of the package, “specially designed” for ceramic microcircuit packages controlled by 3A001 and that have a throughput equal to or more than one package per Minute.</p> <p><b>b.4. Filters for clean rooms</b> capable of providing an air environment of 10 or less particles of 0.3 micrometer or smaller per 0.02832 m<sup>3</sup> and <b>filter materials therefor</b></p>



別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 5 条</b></p> <p>一 第一条又は貨物等省令第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する電子管及び光学素子並びにこれらの部分品の検査又は試験のために特に設計した装置</p> <p>二 半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品のために特に設計した試験装置及び検査装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置</p> <p>イ 処理済みウエハー及び基板（プリント基板又はチップを除く。）の内部又は表面の 0.6 μm 以下の欠陥、エラー又は汚損を自動的に検出するためのプログラム内蔵方式の検査装置であって、パターン比較のための画像の取得技術を用いたもの</p> <p>ロ プログラム内蔵方式の測定及び分析装置であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 半導体物質中の酸素又は炭素の含有量の測定用に特に設計したもの</p> <p>(二) 線幅の測定用のものであって、分解能が 1 μm 以下のもの</p> <p>(三) 10 μm 以下の平面度の測定用に特に設計したものであって、分解能が 1 μm 以下のもの</p>	<p><b>3B992 Equipment not controlled by 3B002 for the inspection or testing of electronic “components” and materials, and “specially designed” “parts,” “components” and “accessories” therefor ;</b></p> <p>※ EU リストの X.B.I.002 項も同内容</p> <p>a. Equipment “specially designed” for <b>the inspection or testing of electron tubes, optical elements</b> and “specially designed” “parts” and “components” therefor controlled by 3A001 or 3A991;</p> <p>b. Equipment “specially designed” for <b>the inspection or testing of semiconductor devices, integrated circuits and “electronic assemblies”</b>, as follows, and systems incorporating or having the characteristics of such equipment:</p> <p>b.1. “Stored program controlled” <b>inspection equipment for the automatic detection of defects, errors or contaminants</b> of 0.6 micrometer or less in or on processed wafers, “substrates”, other than printed circuit boards or chips, using optical image acquisition techniques for pattern comparison;</p> <p>b.2. “Specially designed” “stored program controlled” <b>measuring and analysis equipment</b>, as follows:</p> <p>b.2.a. “Specially designed” for the measurement of oxygen or carbon content in semiconductor materials;</p> <p>b.2.b. Equipment for line width measurement with a resolution of 1 micrometer or finer;</p> <p>b.2.c. “Specially designed” flatness measurement instruments capable of measuring deviations from flatness of 10 micrometer or less with a resolution of 1 micrometer or finer.</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 5 条 二号</b>のつづき</p> <p>ハ プログラム内蔵方式の<b>ウエハープロービング試験装置</b>であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 位置決め精度の絶対値が 3.5 μm未満のもの</p> <p>(二) 端子数が 68 を超える半導体素子及び集積回路を試験できるもの</p> <p>(三) 1 GHz を超える周波数で試験できるもの</p> <p>ニ <b>試験装置</b>であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 半導体素子及びパッケージに封入されていないダイの試験用に特に設計したもののうち、プログラム内蔵方式のものであって、18GHz を超える周波数で試験ができるもの</p> <p>(二) 集積回路及びその組立品の試験用に特に設計したもののうち、プログラム内蔵方式のものであって、次のいずれかに該当する試験ができるもの</p> <p>1 20MHz を超えるパターンレートで実施するもの</p> <p>2 10MHz 超 20MHz 以下のパターンレートで実施するものであって、端子数が 68 を超えるパッケージを対象とするもの</p> <p>(三) 1,200 nm を超える波長でフォーカルプレーンアレーの性能を評価するために特に設計したもののうち、電子計算機による評価又はプログラム内蔵方式による評価を用いるものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>1 直径 0.12 mm未満の走査光スポットを用いるもの</p> <p>2 光感度性能パラメータの計測用及び周波数応答、変調伝達関数、応答の均一度又はノイズの評価用に設計したもの</p> <p>3 縦 32 ライン画素、横 32 ライン画素を超える画像を生成することができるアレーを評価するために設計したもの</p>	<p><b>3B992 b</b> のつづき</p> <p>b.3. “Stored program controlled” <b>wafer probing equipment</b> having any of the following characteristics:</p> <p>b.3.a. Positioning accuracy finer than 3.5 micrometer;</p> <p>b.3.b. Capable of testing devices having more than 68 terminals; or</p> <p>b.3.c. Capable of testing at a frequency exceeding 1 GHz</p> <p>b.4. <b>Test equipment</b> as follows:</p> <p>b.4.a. “Stored program controlled” equipment “specially designed” for testing discrete semiconductor devices and unencapsulated dice, capable of testing at frequencies exceeding 18 GHz;</p> <p>b.4.b. “Stored program controlled” equipment “specially designed” for testing integrated circuits and “electronic assemblies” thereof, capable of functional testing:</p> <p>b.4.b.1. At a ‘pattern rate’ exceeding 20 MHz; or</p> <p>b.4.b.2. At a ‘pattern rate’ exceeding 10 MHz but not exceeding 20 MHz and capable of testing packages of more than 68 terminals</p> <p>b.4.c. Equipment “specially designed” for determining the performance of focal-plane arrays at wavelengths of more than 1,200 nm, using “stored program controlled” measurements or computer aided evaluation and having any of the following characteristics:</p> <p>b.4.c.1. Using scanning light spot diameters of less than 0.12 mm;</p> <p>b.4.c.2. Designed for measuring photosensitive performance parameters and for evaluating frequency response, modulation transfer function, uniformity of responsivity or noise; or</p> <p>b.4.c.3. Designed for evaluating arrays capable of creating images with more than 32 x 32 line elements</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 5 条 二号</b> のつづき</p> <p>ホ レーザーシステム及び三キロエレクトロンボルト以下のエネルギーで動作するために設計した<b>電子ビーム試験装置</b>であって、通電状態の半導体素子を非接触のプロブで検査するためのもののうち、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) ビームブランキング又は検出器を用いたストロボ機能を有するもの</p> <p>(二) 電圧測定用の電子分光計であって、分解能が 0.5V 未満であるもの</p> <p>(三) 集積回路の性能を解析するための電気試験用のもの</p> <p>ヘ マスク又は半導体素子の製造、修理、物理的レイアウト解析及び試験を行うことができるように特に設計した<b>多機能式の集束イオンビーム装置</b>のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次の (一) 及び (二) に該当するもの</p> <p>(一) 目標に対するビームの位置決めをフィードバック方式により行うものであって、位置決め精度の絶対値が 1 μm 以下のもの</p> <p>(二) デジタルアナログ変換精度が 12 ビットを超えるもの</p> <p>ト レーザー発振器を用いた<b>粒度測定装置</b>であって、空気中の粒子の径及び分布を測定するために設計したもののうち、次の (一) 及び (二) に該当するもの</p> <p>(一) 0.02832 立方メートル毎分以上の流速で 0.2 μm 以下の粒子径を測定できるもの</p> <p>(二) 国際標準化機構が定めた規格 I S O 14644—1 で定めるクラス 4 又はそれ以上の空気清浄度を測定できるもの</p>	<p><b>3B992b</b> のつづき</p> <p>b.5. <b>Electron beam test systems</b> designed for operation at 3 keV or below, or <b>“laser” beam systems</b>, for non-contactive probing of powered up semiconductor devices having any of the following:</p> <p>b.5.a. Stroboscopic capability with either beam blanking or detector strobing;</p> <p>b.5.b. An electron spectrometer for voltage measurements with a resolution of less than 0.5 V; or</p> <p>b.5.c. Electrical tests fixtures for performance analysis of integrated circuits;</p> <p>b.6. “Stored program controlled” <b>multifunctional focused ion beam systems</b> “specially designed” for manufacturing, repairing, physical layout analysis and testing of masks or semiconductor devices and having either of the following characteristics:</p> <p>b.6.a. Target-to-beam position feedback control precision of 1 micrometer or finer; or</p> <p>b.6.b. Digital-to-analog conversion accuracy exceeding 12 bit;</p> <p>b.7. Particle measuring systems employing “lasers” designed for <b>measuring particle size and concentration</b> in air having both of the following characteristics:</p> <p>b.7.a. Capable of measuring particle sizes of 0.2 micrometer or less at a flow rate of 0.02832 m<sup>3</sup> per minute or more; and</p> <p>b.7.b. Capable of characterizing Class 10 clean air or better</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 6 条</b> 輸出令別表第二の三第二号へに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、193 nm から 370 nm までの波長の光で使用するよう最適化した<b>ポジ型レジスト</b>とする。</p>	<p><b>3C992 Positive resists</b> designed for semiconductor lithography specially adjusted (optimized) for use at wavelengths between 370 and 193 nm. ※ EU リストの X.C.I. 001 項と同内容</p>
<p><b>第 7 条</b> 一 <b>電子計算機</b>及びその附属装置並びにこれらの部分品であって、70 度上の温度まで使用できるように設計したもの</p>	<p><b>4A994 Computers</b>, “electronic assemblies” and related equipment, not controlled by 4A001 or 4A003, and “specially designed” “parts” and “components” therefor (see List of Items Controlled) ※ EU リストの X.A.II. 001 項と同内容 a. <b>Electronic computers and related equipment</b>, and “electronic assemblies” and “specially designed” “parts” and “components” therefor, rated for operation at an ambient temperature above 343 K (70°C);</p>
<p>二 信号処理又は画像強調のための装置を組み込んだ<b>電子計算機</b>であって、加重最高性能が 0.0128 実効テラ演算以上のもの 註) 信号処理装置・画像強調装置を組み込んでいないなら規制外に見える(誤訳の可能性大)</p>	<p>b. <b>“Digital computers”</b>, including equipment of “signal processing” or image enhancement”, having an “Adjusted Peak Performance” (“APP”) equal to or greater than 0.0128 Weighted TeraFLOPS (WT);</p>
<p>三 <b>電子計算機</b>であって、16 以上のプロセッサを集合させることにより性能を向上させるために特に設計又は改造したもの 註) 原文は“Electronic assemblies”だから「電子計算機として出来上がった姿かたち」をしているものを指してはいないようだ。</p>	<p>c. <b>“Electronic assemblies”</b> that are “specially designed” or modified to enhance performance by aggregation of processors, as follows: c.1. Designed to be capable of aggregation in configurations of 16 or more processors;</p>
<p>四 信号処理又は画像強調のための装置であって、加重最高性能が 0.0128 実効テラ演算以上のもの</p>	<p>f. Equipment for <b>“signal processing”</b> or <b>“image enhancement”</b> having an “Adjusted Peak Performance” (“APP”) equal to or greater than 0.0128 Weighted TeraFLOPS WT;</p>
<p>五 第八条に該当する<b>端末インターフェース装置</b>を組み込んだ装置</p>	<p>i. Equipment containing <b>“terminal interface equipment”</b> exceeding the limits in 5A991;</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 7 条</b>のつづき</p> <p>六 複数のデジタル電子計算機又はその附属装置の間でデータを転送するように特に設計したデジタル電子計算機の附属装置であって、データ転送速度が 80MByte 毎秒を超えるもの</p>	<p><b>4A994</b> のつづき</p> <p>j. <b>Equipment “specially designed” to provide external interconnection of “digital computers” or associated equipment that allows communications at data rates exceeding 80 Mbyte/s.</b></p>
<p>七 アナログデジタル変換器が組み込まれたハイブリッド電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品であって次のイ及びロに該当するもの</p> <p>イ チャンネル数が 32 以上のもの</p> <p>ロ 符号ビットを除いた分解能が 14 ビット以上のものであって、変換速度が 200,000 回毎秒以上のもの</p>	<p>k. <b>“Hybrid computers” and “electronic assemblies” and “specially designed” “parts” and “components” therefor containing analog-to-digital converters having all of the following characteristics:</b></p> <p>k.1. 32 channels or more; and</p> <p>k.2. A resolution of 14 bit (plus sign bit) or more with a conversion rate of 200,000 conversions/s or more.</p>
<p><b>第 8 条</b></p> <p>一 通信装置であって、124 度を超える温度又は零下 54 度より低い温度で使用できるように特に設計したもの</p>	<p><b>5A991 Telecommunication equipment, not controlled by 5A001 (see List of Items Controlled).</b></p> <p>※ EU リストの X. A. III. 101 項と同内容</p> <p>a. Any type of telecommunications equipment, not controlled by 5A001.a, “specially designed” to operate outside the temperature range from 219 K (-54 °C) to 397 K (124 °C).</p>
<p>二 伝送通信装置並びにその部分品及び附属品であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ デジタル技術（アナログ信号をデジタル信号に変換するものを含む。）を用いた装置であって、最高位多重化レベルにおいて 45 メガビット毎秒を超える伝送速度又は 90 メガビット毎秒を超える総合伝送速度で使用できるように設計したもの</p>	<p>b. <b>Telecommunication transmission equipment and systems,</b> and “specially designed” “parts,” “components” and “accessories” therefor, having any of the following characteristics, functions or features:</p> <p>b.1. Employing digital techniques, including digital processing of analog signals, and designed to operate at a “digital transfer rate” at the highest multiplex level exceeding 45 Mbit/s or a “total digital transfer rate” exceeding 90 Mbit/s;</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 8 条</b>のつづき</p> <p>ロ 9,600 毎秒を超えるデータ信号速度で使用できるモデム</p> <p>ハ デジタル伝送方式を用いた装置のうち、プログラム内蔵方式による回線の切替え機能を有するものであって、一ポート当たり 8.5 メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるもの</p> <p>ニ 次のいずれかを組み込んだ装置</p> <p>(一) 33 メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるローカルエリアネットワーク用の装置及びそれに関連する共通の媒体</p> <p>(二) 通信回路側のデータ信号速度が一回線当たり 64 キロビット毎秒を超える通信制御装置</p> <p>ホ レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 1,000 nm を超える波長のレーザー光を利用するもの</p> <p>(二) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が 45 MHz を超えるもの</p> <p>(三) コヒーレント伝送方式を用いたもの</p> <p>(四) 光波長多重化技術を用いたもの</p> <p>(五) レーザー光を増幅する機能を有するもの</p>	<p><b>5A991</b> のつづき</p> <p>b.2. Modems using the ‘bandwidth of one voice channel’ with a ‘data signaling rate’ exceeding 9,600 bits per second;</p> <p>b.3. Being ‘stored program controlled’ digital cross connect equipment with ‘digital transfer rate’ exceeding 8.5 Mbit/s per port.</p> <p>b.4. Being equipment containing any of the following:</p> <p>b.4.a. ‘Network access controllers’ and their related common medium having a ‘digital transfer rate’ exceeding 33 Mbit/s; or</p> <p>b.4.b. ‘Communication channel controllers’ with a digital output having a ‘data signaling rate’ exceeding 64,000 bit/s per channel;</p> <p>b.5. Employing a ‘laser’ and having any of the following characteristics:</p> <p>b.5.a. A transmission wavelength exceeding 1,000 nm; or</p> <p>b.5.b. Employing analog techniques and having a bandwidth exceeding 45 MHz;</p> <p>b.5.c. Employing coherent optical transmission or coherent optical detection techniques (also called optical heterodyne or homodyne techniques);</p> <p>b.5.d. Employing wavelength division multiplexing techniques; or</p> <p>b.5.e. Performing ‘optical amplification’;</p>



別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 8 条</b>のつづき</p> <p>へ 無線送信機及び無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 人工衛星と地上局間で使用するものであって、31GHz を超える周波数で動作するもの</p> <p>(二) (一) 以外の用途に使用するものであって、26.5GHz を超える周波数で動作するもの</p> <p>(三) 総合伝送速度が 8.5 メガビット毎秒を超えるものであって、四値を超える直交振幅変調技術を用いたもの</p> <p>(四) 総合伝送速度が 8.5 メガビット毎秒以下のものであって、一六値を超える直交振幅変調技術を用いたもの</p> <p>(五) 直交振幅変調技術以外のデジタル変調技術を用いたものであって、スペクトラム効率が 3 ビット毎秒毎 Hz を超えるもの</p> <p>(六) 1.5MHz 以上 87.5MHz 以下の周波数範囲で使用できるものうち、適応型の干渉信号抑圧技術を用いたものであって、干渉信号を 15 dBを超えて抑圧することができるように設計したもの</p>	<p><b>5A991</b> のつづき</p> <p>b.6. Radio equipment operating at input or output frequencies exceeding:</p> <p>b.6.a. 31 GHz for satellite-earth station applications; or</p> <p>b.6.b. 26.5 GHz for other applications;</p> <p>b.7. Being radio equipment employing any of the following:</p> <p>b.7.a. Quadrature-amplitude-modulation (QAM) techniques above level 4 if the “total digital transfer rate” exceeds 8.5 Mbit/s;</p> <p>b.7.b. QAM techniques above level 16 if the “total digital transfer rate” is equal to or less than 8.5 Mbit/s;</p> <p>b.7.c. Other digital modulation techniques and having a “spectral efficiency” exceeding 3 bit/s/Hz; or</p> <p>b.7.d. Operating in the 1.5 MHz to 87.5 MHz band and incorporating adaptive techniques providing more than 15 dB suppression of an interfering signal.</p>
<p><b>三 電子式交換装置</b>及びその附属装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品及び附属品</p> <p>イ パケットモード動作用に設計したデータ交換装置並びにその部分品及び附属装置</p> <p>ロ データグラム方式によりパケットデータのルート指定又は交換を行うもの</p>	<p><b>c. “Stored program controlled” switching equipment</b> and related signaling systems, having any of the following characteristics, functions or features, and “specially designed” “parts,” “components” and “accessories” therefor</p> <p>c.1. “Data (message) switching” equipment or systems designed for “packet-mode operation” and “parts,” electronic assemblies and “components” therefor, n.e.s.</p> <p>c.3. Routing or switching of ‘datagram’ packets</p>



別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 8 条三号のつづき</b></p> <p>ハ 回線交換のための多重レベルの優先権及びプリエンプションを設定する機能を有するもの</p> <p>ニ セルラー無線送受信機の呼を他の交換装置に自動的に切り替えるように設計したもの又は呼を複数の交換装置が共有する加入者データベースへ自動的に接続するように設計したもの</p> <p>ホ プログラム内蔵方式による回線の切替え機能を有するもののうち、一ポート当たり 8.5 メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるもの</p> <p>ヘ 非対応モード又は準対応モードのいずれかで動作する共通線信号機能を有するもの</p> <p>ト 経路選択方式がダイナミックルーティング方式のもの</p> <p>チ パケット交換機、回線交換機及びルーターであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 通信回路側のデータ信号速度が一回線当たり 64 キロビット毎秒を超える通信制御装置</p> <p>(二) 33 メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるローカルエリアネットワーク用の装置及びそれに関連する共通の媒体</p> <p>リ 電気信号への変換を行わずに光信号の経路選択又は交換を行うことができるように設計したもの</p> <p>ヌ 非同期転送モード技術を用いたもの</p>	<p><b>5A991 c のつづき</b></p> <p>c.5. Multi-level priority and pre-emption for circuit switching;</p> <p>c.6. Designed for automatic hand-off of cellular radio calls to other cellular switches or automatic connection to a centralized subscriber data base common to more than one switch;</p> <p>c.7. Containing “stored program controlled” digital cross connect equipment with “digital transfer rate” exceeding 8.5 Mbit/s per port.</p> <p>c.8. “Common channel signaling” operating in either non-associated or quasi-associated mode of operation;</p> <p>c.9. ‘Dynamic adaptive routing’;</p> <p>c.10. Being packet switches, circuit switches and routers with ports or lines exceeding any of the following:</p> <p>c.10.a. A “data signaling rate” of 64,000 bit/s per channel for a ‘communications channel controller’; or</p> <p>c.10.b. A “digital transfer rate” of 33 Mbit/s for a ‘network access controller’ and related common media;</p> <p>c.11. “Optical switching”;</p> <p>c.12. Employing ‘Asynchronous Transfer Mode’ (‘ATM’) techniques.</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p>第 8 条のつづき</p> <p>四 長さが 50m を超える光ファイバー及び光ファイバーケーブルであって、単一モード用に設計したもの</p>	<p>5A991 のつづき</p> <p>d. <b>Optical fibers and optical fiber cables</b> of more than 50 m in length designed for single mode operation;</p>
<p>五 通信網を集中的に管理する機能を有する装置であって、ノードから受信したデータをダイナミックルーティング方式によるトラフィック制御のために処理するように設計したもの</p>	<p>e. <b>Centralized network control</b> having all of the following characteristics:</p> <p>e.1. Receives data from the nodes; and</p> <p>e.2. Process these data in order to provide control of traffic not requiring operator decisions, and thereby performing ‘dynamic adaptive routing’;</p>
<p>六 フェーズドアレイアンテナであって、次のイからハまでの全てに該当するもの</p> <p>イ 10.5GHz を超える周波数で使用できるように設計したもの</p> <p>ロ 能動素子及び分散配置した部分品を含むもの</p> <p>ハ 電子的にビーム方向及び形状を操作できるように設計したもの</p>	<p>f. <b>Phased array antennas</b>, operating above 10.5 GHz, containing active elements and distributed “parts” or “components,” and designed to permit electronic control of beam shaping and pointing, except for landing systems with instruments meeting International Civil Aviation Organization (ICAO) standards (microwave landing systems (MLS)).</p>
<p>七 移動通信装置並びにその部分品及び附属品</p>	<p>g. <b>Mobile communications equipment</b>, n.e.s., and “parts,” electronic assemblies and “components” therefor; or</p>
<p>八 無線中継通信装置であって、19.7GHz 以上の周波数で使用するよう に設計したもの及びその部分品</p>	<p>h. <b>Radio relay communications equipment</b> designed for use at frequencies equal to or exceeding 19.7 GHz and “parts” and “components” therefor, n.e.s.</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 9 条</b> 輸出令別表第二の三第二号りに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、前条に掲げる貨物の<b>試験装置</b>とする。</p>	<p><b>5B991 Telecommunications test equipment, n.e.s.</b>                      ※ EU リストの X. B. III. 101 項と同内容                      註) 「n.e.s.の」とは「他でリストアップされていない」ということだから元は「リスト非該当の通信試験装置全般」というおそろしく広い概念だった。</p>
<p><b>第 10 条</b> 輸出令別表第二の三第二号ヌに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、第 8 条に該当する<b>通信装置用の光ファイバーの材料として設計したガラスその他の材料のプリフォーム</b>とする。</p>	<p><b>5C991 Preforms of glass or of any other material optimized for the manufacture of optical fibers controlled by 5A991.</b>                      ※ EU リストの X. C. III. 101 項と同内容</p>
<p><b>第 11 条</b> 出令別表第二の三第二号ルに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、<b>暗号装置及び暗号機能を実現するための部分品</b>であって、貨物等省令第八条第九号イからホまでのいずれか及びへに該当するものとする。                      註) リスト規制レベルの暗号機能を持ちながら大量市販品ゆえにリスト規制非該当となった貨物のこと。</p>	<p><b>5A992 Equipment not controlled by 5A002 (see List of Items Controlled)</b>                      c. Commodities classified as <b>mass market encryption commodities</b> in accordance with § 740.17(b) of the EAR.                      ※ EU リストの X. A. III. 201 項と同内容                      註) 細目 a、b は削除されていて現存しない。</p>
<p><b>第 12 条</b>                      一 水中にある物体又は水底に埋もれた物体の<b>探知又は位置の決定</b>ができるもの</p>	<p><b>6A991 Marine or terrestrial acoustic equipment, n.e.s., capable of detecting or locating underwater objects or features or positioning surface vessels or underwater vehicles; and “specially designed” “parts” and “components,” n.e.s.</b></p>
<p>二 水底の地形又は水深を測定できるもの</p>	<p>※ EU リストの X. A. IV. 001 項と同内容</p>
<p>三 <b>船舶の位置を決定</b>できるもの</p>	<p>註) detecting は探知、locating は位置決め                      feature は造作（ゾウサク）即ちデコボコの状態⇔地形                      surface（海上の）と underwater（水中の）両方の船艇の位置を決定できることを EAR は意図していたようである。</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 13 条</b></p> <p>一 イメージ増強管及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ イメージ増強管であって、次の（一）から（三）までの全てに該当するもの</p> <p>（一）400 nm超 1,050 nm以下の波長範囲で最大感度を有するもの</p> <p>（二）電子イメージの増倍機能を有するマイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が 25 μm未満のもの</p> <p>（三）光電陰極が次のいずれかに該当するもの</p> <p>1 主材料にマルチアルカリを用いたもの</p> <p>2 主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いたもの</p> <p>ロ 特に設計したマイクロチャンネルプレートであって、次の（一）及び（二）に該当するもの</p> <p>（一）一のプレートにつき 15,000 以上のチャンネルを有するもの</p> <p>（二）隣接する二のチャンネルの中心間の距離が 25 μm未満のもの</p> <p>二 可視領域又は赤外線領域で動作する直視型のイメージング装置であって、第一号イに該当するイメージ増強管を組み込んだもの</p>	<p><b>6A992 Optical Sensors</b>, not controlled by 6A002, as follows (see List of Items Controlled).</p> <p>※ EU リストの X. A. IV. 002 項と同内容</p> <p><b>a. Image intensifier tubes and “specially designed” “components”</b> therefor, as follows:</p> <p>a.1. Image intensifier tubes having all the following:</p> <p>a.1.a. A peak response in wavelength range exceeding 400 nm, but not exceeding 1,050 nm;</p> <p>a.1.b. A microchannel plate for electron image amplification with a hole pitch (center-to-center spacing) of less than 25 micrometers; and</p> <p>a.1.c. Having any of the following:</p> <p>a.1.c.1. An S-20, S-25 or multialkali photocathode; or</p> <p>a.1.c.2. A GaAs or GaInAs photocathode;</p> <p>a.2. “Specially designed” <b>microchannel plates</b> having both of the following characteristics:</p> <p>a.2.a. 15,000 or more hollow tubes per plate; and</p> <p>a.2.b. Hole pitch (center-to-center spacing) of less than 25 micrometers.</p> <p><b>b. Direct view imaging equipment</b> operating in the visible or infrared spectrum, incorporating image intensifier tubes having the characteristics listed in 6A992.a.1.</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 14 条</b> 輸出令別表第二の三第二号カに掲げる貨物であつて、経済産業大臣が省令で定めるものは、<b>電子式のカメラ</b>であつて、貨物等省令第九条第三号ニ（一）2 又はホ（二）に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだものとする。</p> <p>註）上記で言及された省令 9 条の「第三号ニ（一）2 又はホ（二）」とは熱型のフォーカルプレーンアレーの規制条項。</p> <p>つまり日本では「右記条件ゆえにリスト非該当とされていたカメラ」を、熱型フォーカルプレーンアレー内蔵のものに限り、露・白露向けでは規制対象に戻すということ。（非熱型素子のものは規制対象にしないらしい）</p>	<p><b>6A993 Cameras</b>, not controlled by 6A003 or 6A203, as follows (see List of Items Controlled).</p> <p>※ EU リストの X. A. IV. 003 項と同内容</p> <p>a. <b>Cameras</b> that meet the criteria of <u>Note 3 to 6A003.b.4.</u></p> <p>註）<u>Note 3 to 6A003.b.4.</u>とは「規制フォーカルプレーンアレー内蔵のカメラであっても、撮影速度 9Hz 以下などの条件を満たすものを規制除外する規定。つまり「その条件ゆえにリスト非該当とされていたカメラ」を 6A993a では地域限定で規制しようということ。</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 15 条</b></p> <p>一 光学フィルターであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 250 nmを超える波長の光について使用できるように設計したものであって、多層のコーティングをしたもののうち、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 透過させる光の帯域幅が半値全幅で 1 nm以下であり、かつ、透過率の最大値が 90%以上のもの</p> <p>(二) 透過させる光の帯域幅が半値全幅で 0.1 nm以下であり、かつ、透過率の最大値が 50%以上のもの</p> <p>ロ 250 nmを超える波長の光について使用できるように設計したものであって、次の (一) から (四) までの全てに該当するもの</p> <p>(一) 透過させる光の波長を 500 nm以上変更することができるもの</p> <p>(二) 透過させる光の瞬時周波数の帯域幅が半値全幅で 1.25 nm以下のもの</p> <p>(三) 0.1m 秒以内に、1 nm以下の精度で透過させる光の波長を再設定できるもの</p> <p>(四) 透過率の最大値が 91%以上の波長帯の数が 1 のもの</p> <p>ハ 遮光スイッチ用のものであって、視野が三〇度以上であり、かつ、応答時間が 1 n 秒以下のもの</p>	<p><b>6A994 Optics</b>, not controlled by 6A004, as follows (see List of Items Controlled).</p> <p>※ EU リストの X. A. IV. 004 項と同内容</p> <p><b>a. Optical filters:</b></p> <p>a.1. For wavelengths longer than 250 nm, comprised of multi-layer optical coatings and having either of the following:</p> <p>a.1.a. Bandwidths equal to or less than 1 nm Full Width Half Intensity (FWHI) and peak transmission of 90% or more; or</p> <p>a.1.b. Bandwidths equal to or less than 0.1 nm FWHI and peak transmission of 50% or more;</p> <p>a.2. For wavelengths longer than 250 nm, and having all of the following:</p> <p>a.2.a. Tunable over a spectral range of 500 nm or more;</p> <p>a.2.b. Instantaneous optical bandpass of 1.25 nm or less;</p> <p>a.2.c. Wavelength resettable within 0.1ms to an accuracy of 1 nm or better within the tunable spectral range; and</p> <p>a.2.d. A single peak transmission of 91% or more;</p> <p>a.3. Optical opacity switches (filters) with a field of view of 30° or wider and a response time equal to or less than 1 ns;</p>
<p>二 ふっ化物のファイバーケーブル及びそのための光ファイバーであって、1,000 nm超 3,000 nm以下の波長範囲における光の減衰率が 1 km当たり 4 dB未満のもの</p>	<p><b>b. “Fluoride fiber” cable, or optical fibers therefor</b>, having an attenuation of less than 4 dB/km in the wavelength range exceeding 1,000 nm but not exceeding 3,000 nm.</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 16 条 (レーザーの規制)</b></p> <p>一 二酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 持続波の定格出力が 10kw を超えるもの</p> <p>ロ 10μ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 平均出力が 10kW を超えるもの</p> <p>(二) パルスのピーク出力が 100kW を超えるもの</p> <p>ハ 10μ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 一パルス当たり 5J を超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が 2.5Kw を超えるもの</p> <p>(二) 平均出力が 2.5kW を超えるもの</p>	<p><b>6A995 “Lasers”</b> as follows (see List of Items Controlled).</p> <p>※ EU リストの X. A. IV. 005 項と同内容</p> <p>a. <b>Carbon dioxide (CO2) “lasers”</b> having any of the following:</p> <p>a.1. A CW output power exceeding 10 kW;</p> <p>a.2. A pulsed output with a “pulse duration” <b>exceeding 10 microseconds;</b> and</p> <p>a.2.a. An average output power exceeding 10 kW; or</p> <p>a.2.b. A pulsed “peak power” exceeding 100 kW; or</p> <p>a.3. A pulsed output with a “pulse duration” <b>equal to or less than 10 microseconds;</b> and</p> <p>a.3.a. A pulse energy exceeding 5 J per pulse and “peak power” exceeding 2.5 kW; or</p> <p>a.3.b. An average output power exceeding 2.5 kW;</p>
<p>二 半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 単一横モードのパルスを発振するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 平均出力が 100 mW を超えるもの</p> <p>(二) 1,050 nm を超える波長で使用するよう設計したもの</p> <p>ロ 多重横モードのパルスを発振するように設計した半導体レーザー発振器及び個別の半導体レーザー発振器を集積化した半導体レーザーアレーであって、1,050nm を超える波長で使用するよう設計したもの</p>	<p>b. <b>Semiconductor lasers</b>, as follows:</p> <p>b.1. Individual, <b>single-transverse mode</b> semiconductor “lasers” having:</p> <p>b.1.a. An average output power exceeding 100 mW; or</p> <p>b.1.b. A wavelength exceeding 1,050 nm;</p> <p>b.2. Individual, <b>multiple-transverse mode</b> semiconductor “lasers”, or arrays of individual semiconductor “lasers”, having a wavelength exceeding 1,050 nm;</p>
<p>三 ルビーレーザー発振器であって、一パルス当たり 20J を超えるパルスを発振するもの</p>	<p>c. <b>Ruby “lasers”</b> having an output energy exceeding 20 J per pulse;</p>



別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 16 条</b> (レーザーの規制)</p> <p>四 <b>波長可変レーザー発振器以外のパルスレーザー発振器</b>であって、975 nm超 1,050nm 以下の波長範囲で使用するよう設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 1 n 秒以上 1 μ 秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) <b>単一横モード</b>で発振するものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>1 ウォールプラグ効率が 12%を超えるもののうち、平均出力が 10W を超えるものであって、パルス繰り返し周波数が 1Khz を超えて動作するもの</p> <p>2 平均出力が 20W を超えるもの</p> <p>(二) <b>多重横モード</b>で発振するものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>1 ウォールプラグ効率が 18%を超えるものであって、平均出力が 30W を超えるもの</p> <p>2 ピーク出力が 200 MWを超えるもの</p> <p>3 平均出力が 50W を超えるもの</p>	<p><b>6A995</b> “Lasers” as follows (see List of Items Controlled).</p> <p>d. <b>Non-“tunable” “pulsed lasers”</b> having an output wavelength exceeding 975 nm but not exceeding 1,150 nm and having any of the following:</p> <p>d.1. A “pulse duration” equal to or exceeding 1 ns but not exceeding 1 μs, and having any of the following:</p> <p>d.1.a. <b>A single transverse mode</b> output and having any of the following:</p> <p>d.1.a.1. A ‘wall-plug efficiency’ exceeding 12% and an “average output power” exceeding 10 W and capable of operating at a pulse repetition frequency greater than 1kHz; or</p> <p>d.1.a.2. An “average output power” exceeding 20 W; or</p> <p>d.1.b. <b>A multiple transverse mode</b> output and having any of the following:</p> <p>d.1.b.1. A ‘wall-plug efficiency’ exceeding 18% and an “average output power” exceeding 30W;</p> <p>d.1.b.2. A “peak power” exceeding 200 MW; or</p> <p>d.1.b.3. An “average output power” exceeding 50 W; or</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 16 条四号</b>のつづき</p> <p>ロ 1 <math>\mu</math> 秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>1 ウォールプラグ効率が 12%を超えるもののうち、平均出力が 10W を超えるものであって、パルス繰り返し周波数が 1 kHz を超えて動作するもの</p> <p>2 平均出力が 20W を超えるもの</p> <p>(二) <b>多重横モード</b>で発振するものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>1 ウォールプラグ効率が 18%を超えるものであって、平均出力が 30W を超えるもの</p> <p>2 平均出力が 500W を超えるもの</p>	<p><b>6A995</b> “Lasers” as follows (see List of Items Controlled).</p> <p>d.2. A “pulse duration” exceeding 1 <math>\mu</math>s and having any of the following:</p> <p>d.2.a. <b>A single transverse mode</b> output and having any of the following:</p> <p>d.2.a.1. A ‘wall-plug efficiency’ exceeding 12% and an “average output power” exceeding 10 W and capable of operating at a pulse repetition frequency greater than 1 kHz; or</p> <p>d.2.a.2. An “average output power” exceeding 20 W; or</p> <p>d.2.b. <b>A multiple transverse mode</b> output and having any of the following:</p> <p>d.2.b.1. A ‘wall-plug efficiency’ exceeding 18% and an “average output power” exceeding 30 W; or</p> <p>d.2.b.2. An “average output power” exceeding 500 W;</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p>第 16 条 (レーザーの規制)</p> <p>五 波長可変レーザー発振器以外の持続波レーザー発振器であって、975 nm 超 1,150 nm 以下の波長範囲で使用するよう設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 単一横モードで発振するものであって次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) ウォールプラグ効率が 12% を超えるものうち、平均出力が 10W を超えるものであって、パルス繰り返し周波数が 1 kHz を超えて動作するもの</p> <p>(二) 平均出力が 50W を超えるもの</p> <p>ロ 多重横モードで発振するものであって次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) ウォールプラグ効率が 18% を超えるものであって、平均出力が 30W を超えるもの</p> <p>(二) 平均出力が 500W を超えるもの</p>	<p>6A995</p> <p>e. Non-“tunable” continuous wave “(CW) lasers”, having an output wavelength exceeding 975 nm but not exceeding 1,150nm and having any of the following:</p> <p>e.1. A <b>single transverse mode</b> output and having any of the following:</p> <p>e.1.a. A ‘wall-plug efficiency’ exceeding 12% and an “average output power” exceeding 10 W and capable of operating at a pulse repetition frequency greater than 1 kHz; or</p> <p>e.1.b. An “average output power” exceeding 50 W; or</p> <p>e.2. A <b>multiple transverse mode</b> output and having any of the following:</p> <p>e.2.a. A ‘wall-plug efficiency’ exceeding 18% and an “average output power” exceeding 30 W; or</p> <p>e.2.b. An “average output power” exceeding 500 W;</p>
<p>六 波長可変レーザー発振器以外のレーザー発振器であって、1,400 nm 超 1,555 nm 以下の波長範囲で使用するよう設計したものうち、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 一パルス当たり 100mJ を超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が 1W を超えるもの</p> <p>ロ 平均出力又は持続波の定格出力が 1W を超えるもの</p>	<p>f. Non-“tunable” “lasers”, having a wavelength exceeding 1,400 nm, but not exceeding 1555 nm and having any of the following:</p> <p>f.1. An output energy exceeding 100 mJ per pulse and a pulsed “peak power” exceeding 1 W; or</p> <p>f.2. An average or CW output power exceeding 1 W;</p>
<p>七 自由電子レーザー発振器</p>	<p>g. Free electron “lasers.”</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 17 条 (磁力計の規制)</b></p> <p>一 磁力計であって、感度 (帯域周波数の平方根当たりで表した実効値をいう。) が 1.0nT 未満のもの</p>	<p><b>6A996 “Magnetometers”</b> not controlled by ECCN 6A006, “Superconductive” electromagnetic sensors, and “specially designed” “components” therefor, as follows (see List of Items Controlled).</p> <p>※ EU リストの X. A. IV. 006 項と同内容</p> <p>a. “Magnetometers”, n.e.s., having a ‘sensitivity’ lower (better) than 1.0 nT (rms) per square root Hz.</p>
<p>二 <b>超電導材料を用いた部分品</b> (ジョセフソン効果素子又は超電導量子干渉素子を含む。) を有するセンサーであって、次のイからハまでの全てに該当するもの</p> <p>イ 当該部分品に使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計したもの</p> <p>ロ 1 kHz以下の周波数の電磁場の変動を検出できるように設計したもの</p> <p>ハ 次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) 最小線幅が 2 μm未満の薄膜超電導量子干渉素子を組み込んだものであって、入出力回路を有するもの</p> <p>(二) 磁場の変動速度が一秒につき 1,000,000 磁束量子を超える場合に使用できるように設計したもの</p> <p>(三) 磁気遮蔽を用いずに、地球磁場中で使用できるように設計したもの</p> <p>(四) 温度係数が温度一度当たり 0.1 磁束量子未満のもの</p>	<p>b. <b>“Superconductive” electromagnetic sensors</b>, “components” manufactured from “superconductive” materials:</p> <p>b.1. Designed for operation at temperatures below the “critical temperature” of at least one of their “superconductive” constituents (including Josephson effect devices or “superconductive” quantum interference devices (SQUIDS));</p> <p>b.2. Designed for sensing electromagnetic field variations at frequencies of 1 KHz or less; and</p> <p>b.3. Having any of the following characteristics:</p> <p>b.3.a. Incorporating thin-film SQUIDS with a minimum feature size of less than 2 μm and with associated input and output coupling circuits;</p> <p>b.3.b. Designed to operate with a magnetic field slew rate exceeding 1 x 10<sup>6</sup>magnetic flux quanta per second;</p> <p>b.3.c. Designed to function without magnetic shielding in the earth’s ambient magnetic field; or</p> <p>b.3.d. Having a temperature coefficient less (smaller) than 0.1 magnetic flux quantum/K.</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 18 条 (重力計の規制)</b></p> <p>一 静止状態における測定精度の絶対値が 100 <math>\mu</math> Gal 未満のもの</p>	<p><b>6A997 Gravity meters (gravimeters)</b> for ground use, n.e.s., as follows (see List of Items Controlled).</p> <p>※ EU リストの X. A. IV. 007 項と同内容</p> <p>a. Having a static accuracy of less (better) than 100 microgal; or</p>
<p>二 ウォルドン型のもの</p>	<p>b. Being of the quartz element (Worden) type.</p>
<p><b>第 19 条 (レーダーの規制)</b></p> <p>一 航空機用のレーダー装置及びその部分品</p>	<p><b>6A998 Radar</b> systems, equipment and major “components,” n.e.s., and “specially designed” “components” therefor, as follows (see List of Items Controlled).</p> <p>※ EU リストの X. A. IV. 008 項と同内容</p> <p>a. <b>Airborne radar equipment</b>, n.e.s., and “specially designed” “components” therefor</p>
<p>二 宇宙用のレーザーレーダー (ライダーを含む。) であって、測量用又は気象観測用に特に設計したもの</p>	<p>b. <b>“Space-qualified” “laser” radar or Light Detection and Ranging (LIDAR)</b> equipment “specially designed” for surveying or for meteorological observation.</p>
<p>三 回転翼航空機のために特に設計したミリ波の拡張型ビジョンレーダー撮像システムであって、次のイからニまでの全てに該当するもの</p> <p>イ 動作周波数が 94 GHz のもの</p> <p>ロ 平均出力が 20 mW 未満のもの</p> <p>ハ レーダーのビーム幅が 1 度のもの</p> <p>ニ 動作範囲が 1,500m 以上のもの</p>	<p>c. <b>Millimeter wave enhanced vision radar imaging systems</b> “specially designed” for rotary wing aircraft and having all of the following:</p> <p>c.1. Operates at a frequency of 94 GHz;</p> <p>c.2. An average output power of less than 20 mW;</p> <p>c.3. Radar beam width of 1 degree; and</p> <p>c.4. Operating range equal to or greater than 1500 m.</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 20 条 (信号処理装置の規制)</b></p> <p>一 地震波を検知する装置 (三に該当するものを除く。)</p>	<p><b>6A999 Specific processing equipment</b>, as follows (see List of Items Controlled).</p> <p>※ EU リストの X. A. IV. 009 項と同内容</p> <p>a. Seismic detection equipment not controlled in paragraph c.</p>
<p>二 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ</p>	<p>b. Radiation hardened TV cameras, n.e.s.</p>
<p>三 地震波を検知及び分類し、震源の位置を判定するシステム</p>	<p>c. Seismic intrusion detection systems that detect, classify and determine the bearing on the source of a detected signal.</p>
<p><b>第 21 条 (レーザーの製造試験装置の規制)</b></p> <p>一 自由電子レーザー発振器用の磁気ウィグラーを製造、試験又は検査するためのもの</p>	<p><b>6B995 Equipment, including tools, dies, fixtures or gauges, and other “specially designed” “parts,” “components” and “accessories” therefor, “specially designed” or modified for any of the following (see List of Items Controlled).</b></p> <p>※ EU リストの X. B. IV. 001 項と同内容</p> <p>a. For the manufacture or inspection of:</p> <p>a.1. Free electron “laser” magnet wigglers;</p>
<p>二 自由電子レーザー発振器用のフォトインジェクターを製造、試験又は検査するためのもの</p>	<p>a. For the manufacture or inspection of:</p> <p>a.2. Free electron “laser” photo injectors;</p>
<p>三 自由電子レーザー発振器の縦方向の磁場を調整するためのもの</p>	<p>b. For the adjustment, to required tolerances, of the longitudinal magnetic field of free electron “lasers”.</p>
<p><b>第 22 条(光検出器用の光ファイバー及び光検出器の材料規制)</b></p> <p>一 ビート長が 500 mm未満になるように改質した光検出器用の光ファイバー</p> <p>二 光検出器の材料となる物質であって、亜鉛含有量がモル比で 6%以上のも</p>	<p><b>6C992 Optical sensing fibers</b> not controlled by 6A002.d.3 that are modified structurally to have a ‘beat length’ of less than 500 mm (high birefringence) or optical sensor materials not described in 6C002.b and having a zinc content of equal to or more than 6% by ‘mole fraction.’</p> <p>※ EU リストの X.C.IV.001 項と同内容</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p>第 23 条 (光学材料の規制)</p> <p>一 ふっ化物であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ ふっ化化合物であって、純度が 99.999%以上のもの</p> <p>ロ 貨物等省令第九条第十六号ト (一) に該当する化合物から形成したふっ化物ガラス</p>	<p>6C994 Optical materials, as follows (see List of Items Controlled).</p> <p>※ EU リストの X.C.IV.002 項と同内容</p> <p>a. Low optical absorption materials, as follows:</p> <p>a.1. <b>Bulk fluoride compounds</b> containing ingredients with a purity of 99.999% or better; or</p> <p>a.2. <b>Bulk fluoride glass</b> made from compounds controlled by 6C004.e.1;</p>
<p>二 第十五条第二号に該当する光ファイバーのプリフォームであって、ふっ化物の純度が 99.999%以上のもの</p>	<p>b. <b>‘Optical fiber preforms’</b> made from bulk fluoride compounds containing ingredients with a purity of 99.999% or better, “specially designed” for the manufacture of ‘fluoride fibers’ controlled by 6A994.b.</p>
<p>第 24 条 輸出令別表第二の三第二号ウに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、慣性航法装置、方向探知機及びアビオニクス装置並びにこれらの部分品とする。</p>	<p>7A994 <b>Other navigation direction finding equipment, airborne communication equipment, all aircraft inertial navigation systems</b> not controlled under 7A003 or 7A103, and other avionic equipment, including “parts” and “components,” n.e.s.</p> <p>※ EU リストの X.A.V.001 項と同内容</p>
<p>第 25 条 輸出令別表第二の三第二号キに掲げる貨物であって、経済産業大臣が省令で定めるものは、航法装置及びアビオニクス装置の試験装置、検査装置及び製造用の装置とする。</p>	<p>7B994 <b>Other equipment for the test, inspection, or “production” of navigation and avionics equipment.</b></p> <p>※ EU リストの X.B.V.001 項と同内容</p>



別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 26 条（海洋関連の規制）</b></p> <p>一 水中用の観測装置であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 潜水艇に搭載して遠隔操作ができるように特に設計又は改造したカメラ、照明装置、表示装置及び伝送通信装置から構成されるテレビジョン装置であって、空气中で計測された解像度が 500 本を超えるもの</p> <p>ロ 水中用のテレビカメラであって、空气中で計測された解像度が 700 本を超えるもの</p>	<p><b>8A992 Vessels, marine systems or equipment, not controlled by 8A001 or 8A002 and “specially designed” “parts” and “components” therefor, and marine boilers and “parts,” “components,” “accessories,” and “attachments” therefor (see List of Items Controlled).</b></p> <p>※ EU リストの X.A.VI.001 項と同内容</p> <p>a. Underwater vision systems, as follows:</p> <p>a.1. Television systems (comprising camera, lights, monitoring and signal transmission equipment) having a limiting resolution when measured in air of more than 500 lines and “specially designed” or modified for remote operation with a submersible vehicle; or</p> <p>a.2. Underwater television cameras having a limiting resolution when measured in air of more than 700 lines;</p>
<p>二 水中用に特に設計又は改造した、幅が 35 mm以上のフィルムを用いる静止画を撮影する写真機であって、オートフォーカス機能又はリモートフォーカス機能を有するもの</p>	<p>b. <b>Photographic still cameras</b> “specially designed” or modified for underwater use, having a film format of 35 mm or larger, and having autofocusing or remote focusing “specially designed” for underwater use;</p>
<p>三 水中用に特に設計又は改造したストロボ法を用いた照明装置であって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが 300J を超えるもの</p>	<p>c. <b>Stroboscopic light systems</b>, “specially designed” or modified for underwater use, capable of a light output energy of more than 300 J per flash;</p>
<p>四 水中用のカメラ装置（第一号又は第二号に該当するものを除く。）</p>	<p>d. Other underwater camera equipment, n.e.s.;</p>
<p>五 水中における活動用に設計した装置（第一号から第四号まで又は第八号から第十一号までのいずれかに該当するものを除く。）</p>	<p>e. Other submersible systems, n.e.s.,</p>
<p>六 船舶（ゴムボートを含む。）及びその部分品</p>	<p>f. <b>Vessels</b>, n.e.s., including inflatable boats, and “specially designed” “parts” and “components”therefor, n.e.s.;</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p>第 26 条 つづき</p> <p>七 船舶用のエンジン及びその部分品</p>	<p>8A992 つづき</p> <p>g. Marine engines (both inboard and outboard) and submarine engines, n.e.s.; and “specially designed” “parts” and “components” therefor, n.e.s.</p>
<p>八 自給式の水中呼吸用具及び関連装置（第十一号に該当するものを除く。）</p>	<p>h. Other self-contained underwater breathing apparatus (scuba gear) and related equipment, n.e.s.</p>
<p>九 救命胴衣、インフレーションカートリッジ、コンパス、ウェットスーツ、マスク、フィン、ウェイトベルト及び潜水用コンピュータ</p>	<p>i. Life jackets, inflation cartridges, compasses, wetsuits, masks, fins, weight belts, and dive computers;</p>
<p>十 水中用の照明装置（第三号に該当するものを除く。）</p>	<p>j. <b>Underwater lights</b> and propulsion equipment;</p>
<p>十一 エアーシリンダーに充填するために設計したエアコンプレッサー及びろ過装置</p>	<p>k. <b>Air compressors and filtration systems</b> “specially designed” for filling air cylinders.</p>
<p>十二 船舶用のボイラーであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 炉の容積 1 m<sup>3</sup> 当たりの一時間の最大発熱量が 7,079,200KJ 以上となるように設計したもの</p> <p>ロ 1 時間の最大蒸気発生量をボイラーの乾燥重量で除して得た数値が 0.83 以上となるように設計したもの</p>	<p>ℓ. <b>Marine boilers</b> designed to have any of the following characteristics:</p> <p>ℓ.1. Heat release rate (at maximum rating) equal to or in excess of 190,000 BTU per hour per cubic foot of furnace volume; or</p> <p>ℓ.2. Ratio of steam generated in pounds per hour (at maximum rating) to the dry weight of the boiler in pounds equal to or in excess of 0.83.</p>
<p>十三 第十二号に該当する船舶用のボイラーの主要な部分品及び附属品</p>	<p>m. Major “components,” “accessories,” and “attachments” for marine boilers described in 8A992.ℓ.</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 27 条 (ディーゼルエンジン・トラクタの規制)</b></p> <p>一 トラック、トラクター及び自動車用のディーゼルエンジンであつて、キロワットに換算した連続制動馬力が 298 以上のもの</p>	<p><b>9A990 Diesel engines, n.e.s., and tractors and “specially designed” “parts” and “components” therefor, n.e.s. (see List of Items Controlled).</b></p> <p>※ EU リストの X.A.VII.001 項と同内容</p> <p>a. Diesel engines, n.e.s., for trucks, tractors, and automotive applications of continuous brake horsepower of 400 BHP (298 kW) or greater (performance based on SAE J1349 standard conditions of 100 Kpa and 25□)</p>
<p>二 装輪式のトラクターであつて、積載量が九トン以上のもの並びにその主要な部分品及び附属品</p>	<p>b. Off highway wheel tractors of carriage capacity 9 mt (20,000 lbs) or more; and major “components” and “accessories,” n.e.s.</p>
<p>三 トラクターであつて、後輪の車軸の数が一又は二のものうち、一の軸にかかる荷重が九トン以上のもの及びその主要な部分品</p>	<p>c. On-Highway tractors, with single or tandem rear axles rated for 9 mt per axel (20,000 lbs.) or greater and “specially designed” major “components”.</p>
<p><b>第 28 条 (航空機・ガスタービンエンジンの規制)</b></p> <p>一 軍用機のうち、軍事作戦のために特別に装備又は改造していないものであつて、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ レシプロエンジンを使用した輸送機</p> <p>ロ 600 馬力未満のレシプロエンジン又はターボプロップエンジンを使用した練習機</p> <p>ハ レシプロエンジンを使用した多目的機</p> <p>ニ 連絡機</p> <p>ホ レシプロエンジンを使用した偵察機</p>	<p><b>9A991 “Aircraft”, n.e.s., and gas turbine engines not controlled by 9A001 or 9A101 and “parts” and “components,” n.e.s. (see List of Items Controlled).</b></p> <p>a. Military aircraft, demilitarized (not specifically equipped or modified for military operation), as follows:</p> <p>a.1 Cargo aircraft bearing “C” designations and numbered C-45 through C-118 inclusive, C121 through C-125 inclusive, and C-131, using reciprocating engines only.</p> <p>a.2 Trainer aircraft bearing “T” designations and using reciprocating engines or turboprop engines with less than 600 horsepower (s.h.p.).</p> <p>a.3 Utility aircraft bearing “U” designations and using reciprocating engines only.</p> <p>a.4 All liaison aircraft bearing an “L” designation</p> <p>a.5 All observation aircraft bearing “O” designations and using reciprocating engines.</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 28 条 (航空機・ガスタービンエンジンの規制)</b></p> <p>一 軍用機のうち、軍事作戦のために特別に装備又は改造していないものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ レシプロエンジンを使用した輸送機</p> <p>ロ 600 馬力未満のレシプロエンジン又はターボプロップエンジンを使用した練習機</p> <p>ハ レシプロエンジンを使用した多目的機</p> <p>ニ 連絡機</p> <p>ホ レシプロエンジンを使用した偵察機</p>	<p><b>9A991 “Aircraft”, n.e.s., and gas turbine engines not controlled by 9A001 or 9A101 and “parts” and “components,” n.e.s. (see List of Items Controlled).</b></p> <p>※ EU リストで対応するのは X.A.VII.002 項だが、同項は米国リストと違い Aircraft 関連品 (細目 a、b、d) が含まれていない。</p> <p>a. Military aircraft, demilitarized (not specifically equipped or modified for military operation), as follows:</p> <p>a.1 Cargo aircraft bearing “C” designations and numbered C-45 through C-118 inclusive, C121 through C-125 inclusive, and C-131, using reciprocating engines only.</p> <p>a.2 Trainer aircraft bearing “T” designations and using reciprocating engines or turboprop engines with less than 600 horsepower (s.h.p.).</p> <p>a.3 Utility aircraft bearing “U” designations and using reciprocating engines only.</p> <p>a.4 All liaison aircraft bearing an “L” designation</p> <p>a.5 All observation aircraft bearing “O” designations and using reciprocating engines.</p>
<p>二 航空機 (第一号に該当するものを除く。)</p>	<p>b. Aircraft n.e.s.;</p>
<p>三 航空機用のガスタービンエンジン及びその部分品</p>	<p>c. Aero gas turbine engines, and “parts” and “components” “specially designed” therefor.</p>
<p>四 航空機の部分品 (第三号又は第五号に該当するものを除く。)</p>	<p>d. “Parts” and “components,” “specially designed” for “aircraft,” n.e.s.</p>
<p>五 航空機用の与圧呼吸機器及びその部分品</p>	<p>e. Pressurized aircraft breathing equipment, n.e.s.; and “parts” and “components” “specially designed” therefor, n.e.s.</p>

別表第 2-3 貨物省令	米国 CCL
<p><b>第 29 条</b> 輸出令別表第二の三第二号ヤに掲げる貨物であつて、経済産業大臣が省令で定めるものは、<b>落下傘</b>（可導式落下傘及びパラグライダーを含む。）並びにその部分品及び附属装置とする。</p>	<p><b>9A992 Complete canopies, harnesses, and platforms and electronic release mechanisms therefor, except such types as are in normal sporting use.</b>                      ※ EU リストには対応する規制項番なし</p>
<p><b>第 30 条</b> 輸出令別表第二の三第二号マに掲げる貨物であつて、経済産業大臣が省令で定めるものは、<b>振動試験装置</b>及びその部分品とする。</p>	<p><b>9B990 Vibration test equipment and “specially designed” “parts” and “components,” n.e.s</b>                      ※ EU リストの X.B.VII.001 項と同内容</p>
<p><b>第 31 条（ガスタービンエンジンの製造関連規制）</b>                      一 ガスタービンエンジンのブレードの肉厚を測定するために機械的方法以外の方法を用いて自動化した装置</p> <p>二 レーザー加工、ウォータージェット加工、電解加工又は放電加工により貨物等省令第二十五条第三項第二号ルで規定する穴あけ加工を行うための工具、治具及び測定装置</p> <p>三 セラミック製のコアを溶解除去する装置</p> <p>四 セラミック製のコアの製造用の装置及び工具</p> <p>五 セラミック製のシェル用のろう型を製作する装置</p> <p>六 セラミック製のシェルの脱ろう及び焼成装置</p>	<p><b>9B991 “Specially designed” “equipment,” tooling or fixtures, not controlled by 9B001, for manufacturing or measuring gas turbine blades, vanes or tip shroud castings, as follows (see List of Items Controlled).</b></p> <p>a. Automated equipment using non-mechanical methods for measuring airfoil wall thickness;</p> <p>b. Tooling, fixtures or measuring equipment for the “laser”, water jet or ECM/EDM hole drilling processes controlled by 9E003.c;</p> <p>c. Ceramic core leaching equipment;</p> <p>d. Ceramic core manufacturing equipment or tools</p> <p>e. Ceramic shell wax pattern preparation equipment;</p> <p>f. Ceramic shell burn out or firing equipment.</p>